応用物理学会シリコンテクノロジー研究会第133回 研究集会プログラム

日 時: 平成23年2月18日(金)13:00~17:50

場所:東京大学浅野キャンパス工学部9号館1階大会議室

(東京都文京区弥生 2-11-16、千代田線根津駅或いは南北線東大前駅下車)

http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_10_j.html

担当: ナノ・マイクロファブリケーション研究委員会

協賛:応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会

テーマ: 最先端プラズマプロセスにおけるダメージ/バラつき/異物制御

スコープ: 2010年秋冬に開催されたDPS、AVS、GECなどの国際学会で発表された集積デバイス製造のための先端プラズマプロセスに関する興味深い講演を招待し、さらに深い議論を行う。

参加費: 分科会会員 2000円 分科会非会員 4000円 当日お受け致します(事前登録不要)

講演時間 25 分(質疑含む)

講演スケジュール (敬称略)

13:00-13:05 開会の辞 辰巳 哲也 (ソニー(株))

13:05-13:30 大気圧プラズマジェット照射急速熱処理によるナノドットおよび極浅接合形成

東 清一郎 (広島大学)

13:30-13:55 磁性体および Si 系材料反応性イオンエッチングの表面反応解析

浜口 智志 (大阪大学)

13:55-14:20 プラズマプロセス中材料の表面反応の機構解析

石川 健治 (名古屋大学)

14:20-14:45 DC 重畳 CCP 装置を使った HAR-Ox エッチングでの Bowing と Bottom CD の両立

中川 顕 (東京エレクトロン AT(株))

14:45-15:10 SiO₂ コンタクトホールエッチングにおけるチャージング予測

八木澤 卓 (慶應義塾大学)

15:10-15:30 休憩

15:30-15:55 ソース・ドレインエクステンションエピを施したトライゲート型シリコンナノワイ

ヤトランジスタの短チャネル性能と移動度解析

齋藤 真澄 ((株)東芝)

15:55-16:20 **S**i エッチングダメージのモデリング

江利口 浩二 (京都大学)

16:20-16:55 ソース・ドレインエクステンション向けのプラズマドーピング

佐々木 雄一朗 ((株)ユー・ジェー・ティー・ラボ)

16:55-17:20 プラズマエッチング装置におけるダストパーティクル挙動

小林 浩之 ((株)日立製作所)

17:20-17:45 総合討論

17:45-17:50 閉会の辞

林 久貴 ((株)東芝)

17:50- 懇親会(参加費 2000円)